

# IGBT

## ターンオフ時のサージ電圧抑制について

### 要旨

本資料では、弊社 IGBT 製品におけるターンオフ時のサージ電圧抑制メカニズムについて説明いたします。

### 目次

1. 概要 .....	2
2. メカニズム .....	3
2.1 チャンネルクローズ .....	3
2.2 正孔キャリア増加 .....	3
2.3 正孔キャリア消滅 .....	3
3. ロバスト性の確保 .....	4
APPENDIX 語句の定義 .....	5
改訂記録 .....	8

## 1. 概要

IGBT をスイッチング動作させた場合、ターンオフ時にサージ電圧が発生します。

ゲート抵抗 ( $R_{g\ off}$ ) が小さい場合や  $di/dt$  が高い場合にサージ電圧が高くなります。

一般的な対策としてはゲート抵抗 ( $R_{g\ off}$ ) を大きくする方法がありますが、ゲート抵抗 ( $R_{g\ off}$ ) を大きくするとスイッチング損失が増加することになり望ましくありません。

ルネサスの IGBT は、ある一定以下にゲート抵抗を小さくすると（例えば、図 1 に示すような条件では  $R_{g\ off} = 4\ \Omega$  以下、 $25^\circ\text{C}$  時の場合）サージ電圧が抑制される特徴があります。この特徴をセルフクランプモード（ルネサスでの呼称）と言い、次章以降にそのメカニズムを説明します。

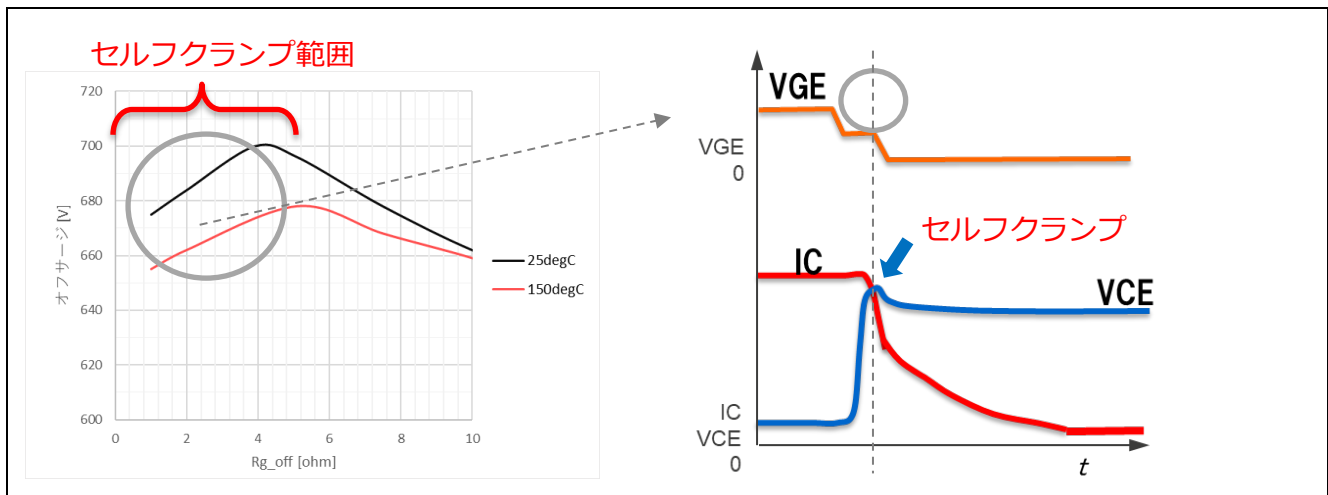


図 1  $R_{g\ off}$ -サージ電圧特性とターンオフ波形 (AE5 IGBT 750V/300A 製品)

## 2. メカニズム

### 2.1 チャンネルクローズ

Rg off が小さい状況においてはチャンネルが急速に閉じられるため電子の供給が早く停止します。

### 2.2 正孔キャリア増加

回路内の誘導電流を維持するために、正孔キャリアが増加してシャットダウン電子と結合します。

### 2.3 正孔キャリア消滅

残存正孔キャリアはゆっくりと消えます。その結果、 $di/dt$  が低くなりテール電流によって、VCE がクランプされます。

ルネサスの IGBT は、このようなセルフクランプのメカニズムが促進されるようなキャリア濃度に設計チューニングされています。

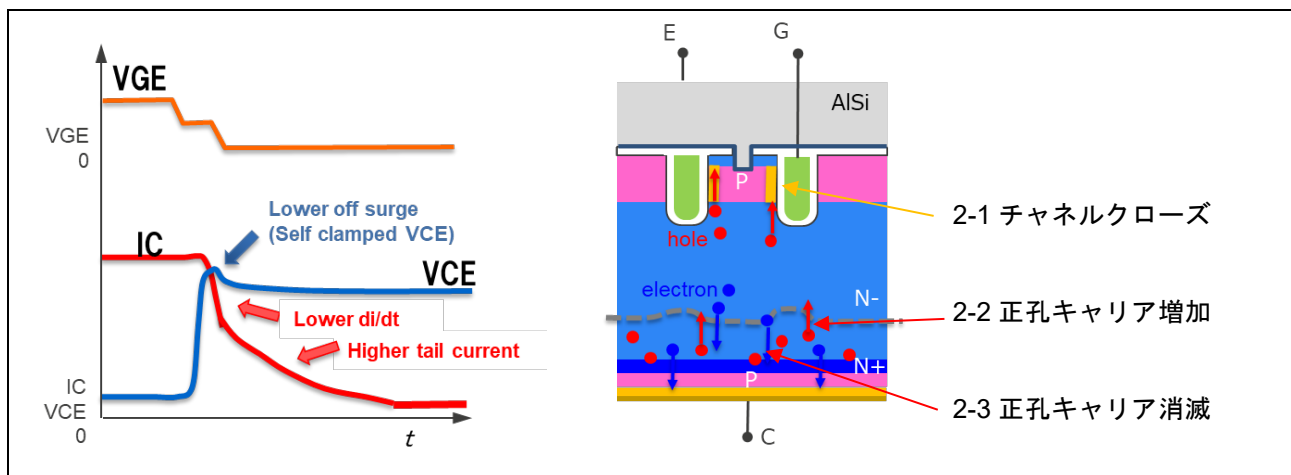


図 2 ターンオフ時の波形とキャリア動作

### 3. ロバスト性の確保

一般的には、ゲート抵抗 ( $R_{g\ off}$ ) が小さい場合や回路の寄生インダクタンスが大きい場合など、ターンオフ時にサージ電圧が高くなり、安全に動作する逆バイアス安全動作領域 (RBSOA : Reverse Bias Safe Operating Area) が狭くなる傾向があります。

しかしながら、前章にて述べたようにルネサスの IGBT はゲート抵抗が小さい状況でもサージ電圧を抑制するセルフクランプモードの特徴が出るように設計チューニングされています。

図 3 にルネサス IGBT AE5 にて、低ゲート抵抗 ( $R_{g\ off} = 3.3\ \Omega$ ) での RBSOA を確認した波形とそのローカスカーブを示します。定格電流の 3 倍の条件下においても、セルフクランプモードによるターンオフ時の安全性が確保されており、ロバスト性を配慮した設計になっているのを確認できます。

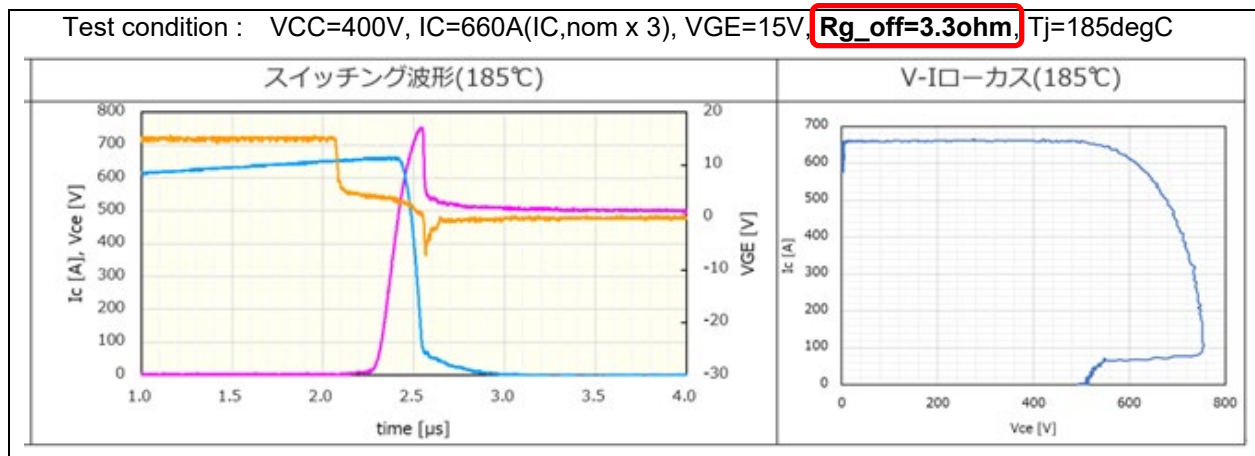


図 3 セルフクランプモードによる RBSOA 検証 (AE5 IGBT 750V/300A 製品)

## APPENDIX 語句の定義

## スイッチング特性

電力変換において、IGBT はスイッチとして使用されます。

スイッチング特性は、図 4 のスイッチング特性測定回路で測定を行っています。

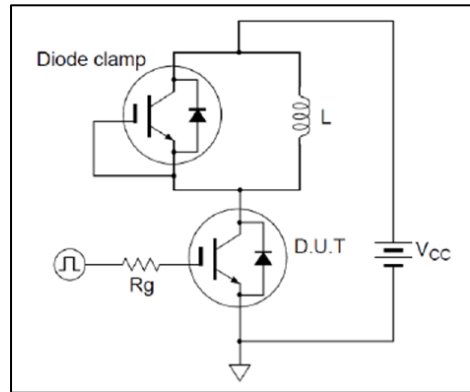


図 4 スwitchング特性測定回路

次項でスイッチング特性において重要なパラメータを説明します。

## スイッチング特性（スイッチング時間）

- $t_{d(on)}$  ターンオン遅延時間  
ゲートエミッタ間電圧が順バイアス電圧の 10% からコレクタ電流が 10% に上昇するまでの時間
- $t_r$  立ち上がり時間  
コレクタ電流が 10% から 90% に上昇するまでの時間
- $t_{d(off)}$  ターンオフ遅延時間  
ゲートエミッタ間電圧が順バイアス電圧の 90% からコレクタ電流が 90% に下降するまでの時間
- $t_f$  立下り時間  
コレクタ電流が 90% から 10% に下降するまでの時間

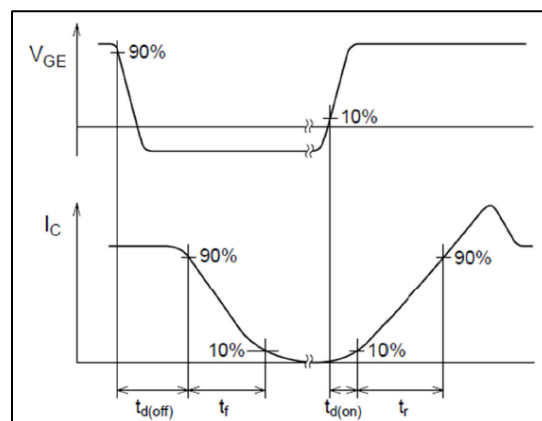


図 5 スwitchング波形

### スイッチング特性（スイッチング損失）

スイッチング損失を 図 6 に示します。

オフ期間損失は  $V_{CE} \times I_C$  で計算できます。

IGBT の損失を計算をすることは、アプリケーションの消費電力を見積もる上でも、接合温度  $T_j$  を推定するためにも非常に重要です。

ターンオン損失エネルギー	$E_{on}$	ターンオン開始からコレクタ・エミッタ間電圧が指定された値に達するまでの間に発生するコレクタ損失の積分値
ターンオフ損失エネルギー	$E_{off}$	ターンオフ開始からコレクタ・エミッタ間電圧が指定された値に達するまでの間に発生するコレクタ損失の積分値
スイッチング損失エネルギー	$E_{total}$	$E_{on}$ と $E_{off}$ の和

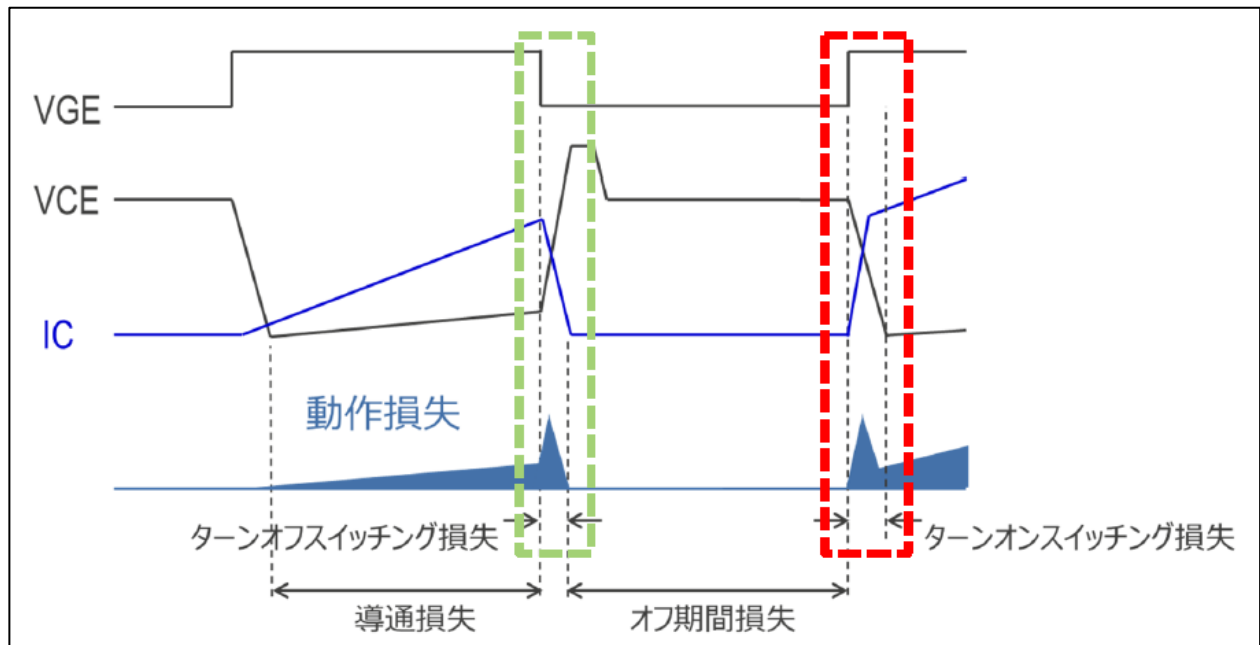


図 6 スwitching損失

**di/dt・サージ電圧**

di/dt とは、スイッチング過渡期の電流の変化量を指します。

ターンオフ動作時においてコレクタ電流が急激に収束し、急峻な di/dt によって寄生インダクタンスでサージ電圧が発生します。

$$V_{\text{surge}} = L \times di/dt$$

高電圧大電流で発生するサージ電圧は大きく、定格を超えると製品の破壊につながるため重要なポイントになります。

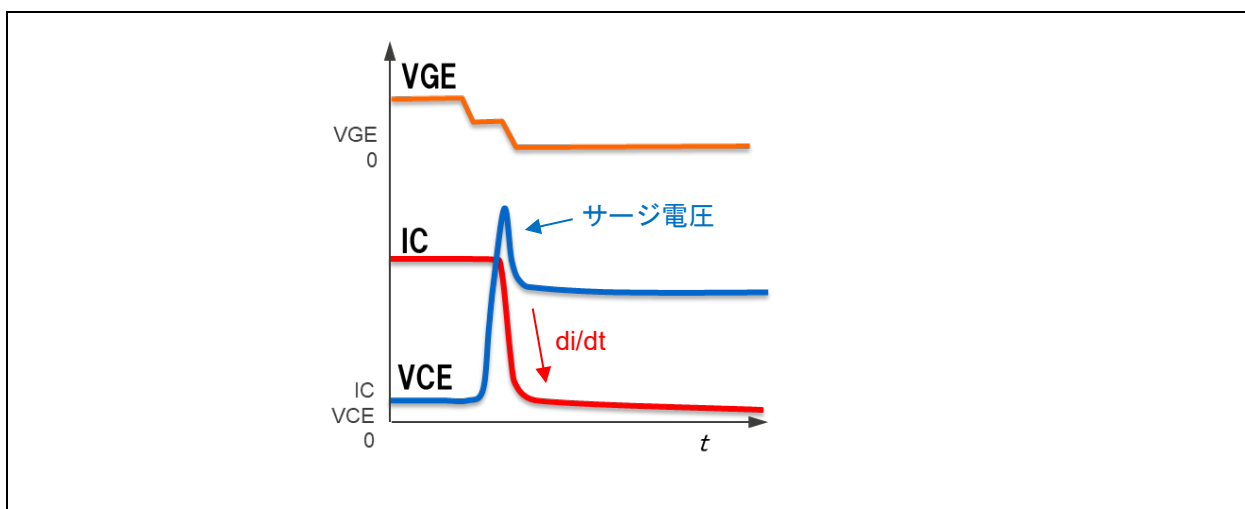


図 7 サージ電圧と di/dt

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
0.10	2024.07.31	-	初版



## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
  8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
  13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)